

S-5712 シリーズは、CMOS 技術を使用して開発した、低電圧動作に対応し低消費電流動作が可能な高精度ホール IC です。磁束密度の大きさを検知して、出力電圧が変化します。磁石と組み合わせることで、さまざまな機器の開閉検出が可能です。

小型の SOT-23-3 または、超小型の SNT-4A パッケージを採用しているため、高密度実装が可能です。

低電圧動作、低消費電流のため、バッテリーで動作する携帯機器に最適です。また、高精度磁気特性のため、磁石と組み合わせた機構の動作ばらつきを小さくすることが可能です。

注意 本製品は AV 機器、OA 機器、通信機器等の一般的な電子機器に使用されることを意図したものです。自動車搭載機器 (カーオーディオ、キーレスエントリー、エンジン制御等を含む)、医療機器用途で使用をお考えの際は必ず事前に弊社窓口まで御相談ください。

■ 特長

- | | |
|--|---|
| ・ 極検知 ^{*1} | : 両極検知、S極検知、N極検知 |
| ・ 磁気検出論理 ^{*1} | : アクティブ "L"、アクティブ "H" |
| ・ 出力形態 ^{*1} | : Nchオープンドレイン出力、CMOS出力 |
| ・ 磁気感度 ^{*1} | : $B_{OP} = 3.0 \text{ mT typ.}, 4.5 \text{ mT typ.}$ |
| ・ 駆動周期 (消費電流) | : 両極検知品
50.50 ms (2.0 μA) typ.
S極、N極検知品
50.85 ms (1.4 μA) typ. |
| ・ 電源電圧範囲 | : 1.6 V ~ 3.5 V |
| ・ 動作温度範囲 | : $T_a = -40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$ |
| ・ 鉛フリー (Sn 100%)、ハロゲンフリー ^{*2} | |

*1. オプション選択が可能。

*2. 詳細は "■ 品目コードの構成" を参照してください。

■ 用途

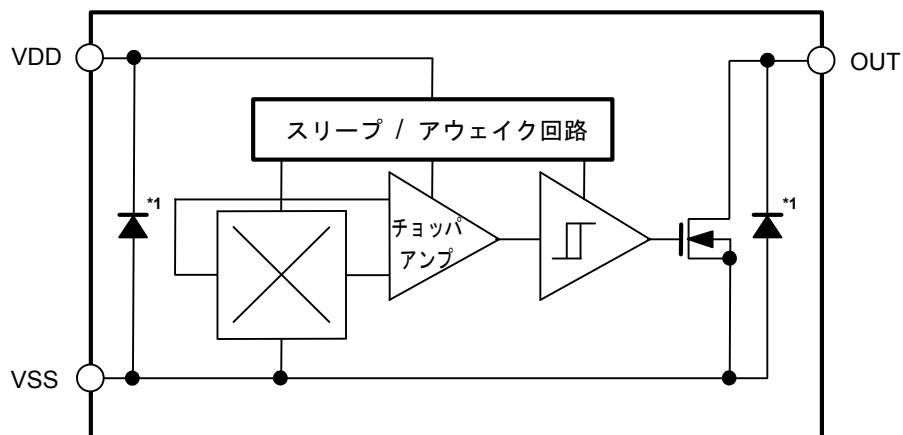
- ・ 携帯電話 (フリップタイプ、スライドタイプなど)
- ・ ラップトップタイプPC
- ・ デジタルビデオカメラ
- ・ 玩具、ゲーム機
- ・ 家庭用電気製品

■ パッケージ

- ・ SOT-23-3
- ・ SNT-4A

■ ブロック図

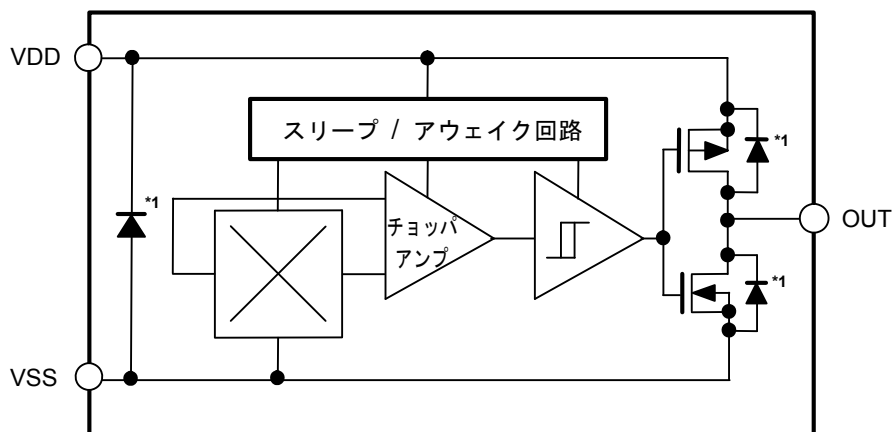
1. Nch オープンドレイン出力品



*1. 寄生ダイオード

図1

2. CMOS出力品

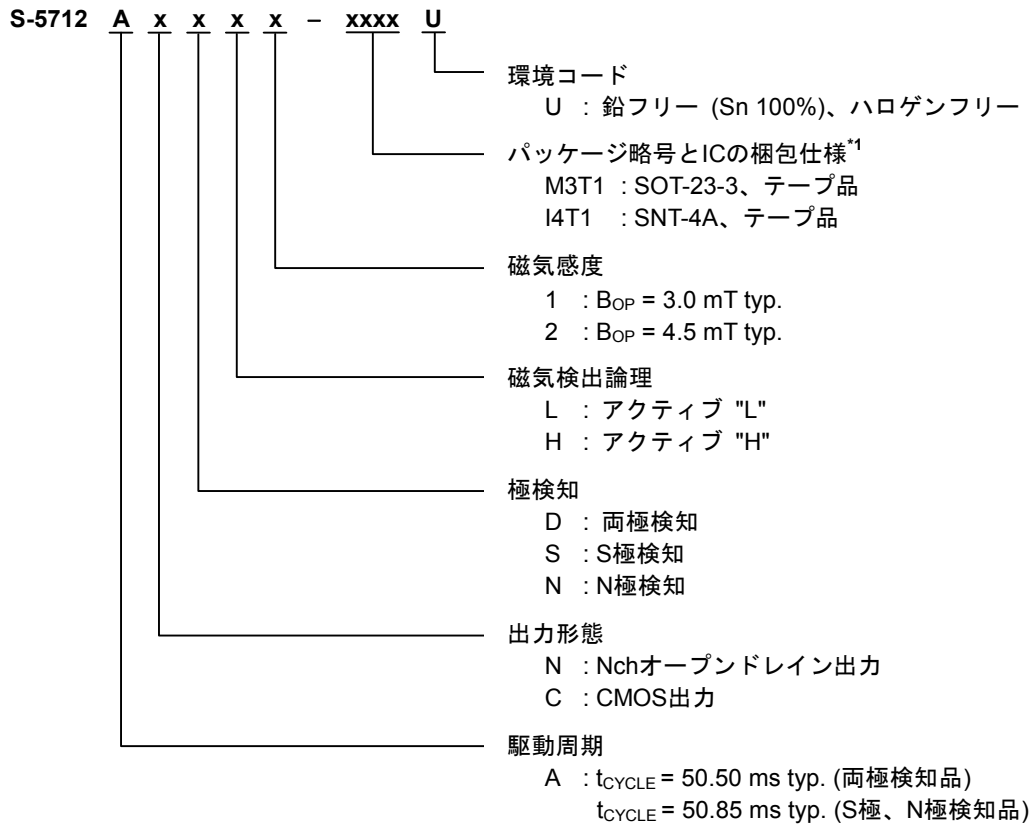


*1. 寄生ダイオード

図2

■ 品目コードの構成

1. 製品名



*1. テープ図面を参照してください。

2. パッケージ

表1 パッケージ図面コード

パッケージ名	外形寸法図面	テープ図面	リール図面	ランド図面
SOT-23-3	MP003-C-P-SD	MP003-C-C-SD	MP003-Z-R-SD	—
SNT-4A	PF004-A-P-SD	PF004-A-C-SD	PF004-A-R-SD	PF004-A-L-SD

3. 製品名リスト

3.1 SOT-23-3

3.1.1 Nchオープンドレイン出力品

表2

製品名	出力形態	極検知	磁気検出論理	磁気感度 (B _{OP})
S-5712ANDL1-M3T1U	Nchオープンドレイン出力	両極検知	アクティブ "L"	3.0 mT typ.
S-5712ANDL2-M3T1U	Nchオープンドレイン出力	両極検知	アクティブ "L"	4.5 mT typ.
S-5712ANSL1-M3T1U	Nchオープンドレイン出力	S極検知	アクティブ "L"	3.0 mT typ.
S-5712ANSL2-M3T1U	Nchオープンドレイン出力	S極検知	アクティブ "L"	4.5 mT typ.

備考 上記以外の製品をご希望のときは、弊社営業部までお問い合わせください

3.1.2 CMOS出力品

表3

製品名	出力形態	極検知	磁気検出論理	磁気感度 (B _{OP})
S-5712ACDL1-M3T1U	CMOS出力	両極検知	アクティブ "L"	3.0 mT typ.
S-5712ACDL2-M3T1U	CMOS出力	両極検知	アクティブ "L"	4.5 mT typ.
S-5712ACDH1-M3T1U	CMOS出力	両極検知	アクティブ "H"	3.0 mT typ.
S-5712ACDH2-M3T1U	CMOS出力	両極検知	アクティブ "H"	4.5 mT typ.
S-5712ACSL1-M3T1U	CMOS出力	S極検知	アクティブ "L"	3.0 mT typ.
S-5712ACSL2-M3T1U	CMOS出力	S極検知	アクティブ "L"	4.5 mT typ.
S-5712ACNL1-M3T1U	CMOS出力	N極検知	アクティブ "L"	3.0 mT typ.
S-5712ACNL2-M3T1U	CMOS出力	N極検知	アクティブ "L"	4.5 mT typ.

備考 上記以外の製品をご希望のときは、弊社営業部までお問い合わせください

3.2 SNT-4A

3.2.1 Nchオープンドレイン出力品

表4

製品名	出力形態	極検知	磁気検出論理	磁気感度 (B _{OP})
S-5712ANDL1-I4T1U	Nchオープンドレイン出力	両極検知	アクティブ "L"	3.0 mT typ.
S-5712ANDL2-I4T1U	Nchオープンドレイン出力	両極検知	アクティブ "L"	4.5 mT typ.
S-5712ANSL1-I4T1U	Nchオープンドレイン出力	S極検知	アクティブ "L"	3.0 mT typ.
S-5712ANSL2-I4T1U	Nchオープンドレイン出力	S極検知	アクティブ "L"	4.5 mT typ.

備考 上記以外の製品をご希望のときは、弊社営業部までお問い合わせください。

3.2.2 CMOS出力品

表5

製品名	出力形態	極検知	磁気検出論理	磁気感度 (B _{OP})
S-5712ACDL1-I4T1U	CMOS出力	両極検知	アクティブ "L"	3.0 mT typ.
S-5712ACDL2-I4T1U	CMOS出力	両極検知	アクティブ "L"	4.5 mT typ.
S-5712ACDH1-I4T1U	CMOS出力	両極検知	アクティブ "H"	3.0 mT typ.
S-5712ACDH2-I4T1U	CMOS出力	両極検知	アクティブ "H"	4.5 mT typ.
S-5712ACSL1-I4T1U	CMOS出力	S極検知	アクティブ "L"	3.0 mT typ.
S-5712ACSL2-I4T1U	CMOS出力	S極検知	アクティブ "L"	4.5 mT typ.
S-5712ACNL1-I4T1U	CMOS出力	N極検知	アクティブ "L"	3.0 mT typ.
S-5712ACNL2-I4T1U	CMOS出力	N極検知	アクティブ "L"	4.5 mT typ.

備考 上記以外の製品をご希望のときは、弊社営業部までお問い合わせください。

■ ピン配置図

1. SOT-23-3

SOT-23-3

Top view

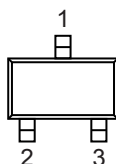


図3

表6

端子番号	端子記号	端子内容
1	VSS	GND端子
2	VDD	電源端子
3	OUT	出力端子

2. SNT-4A

SNT-4A

Top view



図4

表7

端子番号	端子記号	端子内容
1	VDD	電源端子
2	VSS	GND端子
3	NC ^{*1}	無接続
4	OUT	出力端子

*1. NCは電氣的にオープンを示します。
そのため、VDDまたはVSSに接続しても問題ありません。

■ 絶対最大定格

表8

(特記なき場合 : Ta = +25°C)

項目	記号	絶対最大定格	単位
電源電圧	V _{DD}	V _{SS} - 0.3 ~ V _{SS} + 7.0	V
出力電流	I _{OUT}	±1.0	mA
出力電圧	Nchオープンドレイン出力品	V _{OUT}	V _{SS} - 0.3 ~ V _{SS} + 7.0
	CMOS出力品	V _{OUT}	V _{SS} - 0.3 ~ V _{DD} + 0.3
許容損失	SOT-23-3	P _D	430 ^{*1}
	SNT-4A	P _D	300 ^{*1}
動作周囲温度	T _{opr}	-40 ~ +85	°C
保存温度	T _{stg}	-40 ~ +125	°C

*1. 基板実装時

[実装基板]

- (1) 基板サイズ : 114.3 mm × 76.2 mm × t1.6 mm
- (2) 名称 : JEDEC STANDARD51-7

注意 絶対最大定格とは、どのような条件下でも越えてはならない定格値です。万一この定格値を越えると、製品の劣化などの物理的な損傷を与える可能性があります。

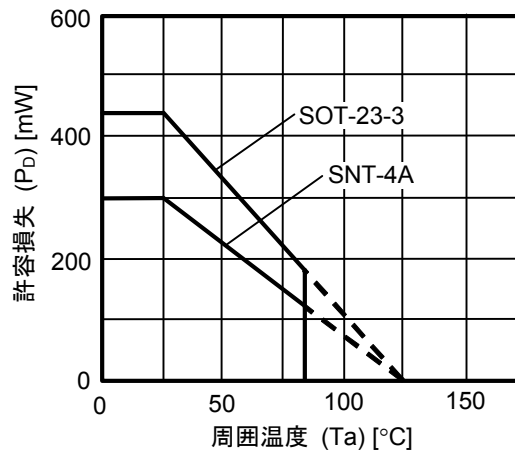


図5 パッケージ許容損失 (基板実装時)

■ 電気的特性

1. 両極検知品

表9

(特記なき場合 : Ta = +25°C、V_{DD} = 1.85 V、V_{SS} = 0 V)

項目	記号	条件		Min.	Typ.	Max.	単位	測定回路
電源電圧	V _{DD}	—		1.60	1.85	3.50	V	—
消費電流	I _{DD}	平均値		—	2.0	4.0	μA	1
出力電圧	V _{OUT}	Nchオープン ドレイン出力品	出力トランジスタNch、 I _{OUT} = 0.5 mA	—	—	0.4	V	2
		CMOS出力品	出力トランジスタNch、 I _{OUT} = 0.5 mA	—	—	0.4	V	2
			出力トランジスタPch、 I _{OUT} = -0.5 mA	V _{DD} - 0.4	—	—	V	3
リーク電流	I _{LEAK}	Nchオープンドレイン出力品 出力トランジスタNch、V _{OUT} = 3.5 V		—	—	1	μA	4
アウェイクモード時間	t _{AW}	—		—	0.10	—	ms	—
スリープモード時間	t _{SL}	—		—	50.40	—	ms	—
駆動周期	t _{CYCLE}	t _{AW} + t _{SL}		—	50.50	100.00	ms	—

2. S極、N極検知品

表10

(特記なき場合 : Ta = +25°C、V_{DD} = 1.85 V、V_{SS} = 0 V)

項目	記号	条件		Min.	Typ.	Max.	単位	測定回路
電源電圧	V _{DD}	—		1.60	1.85	3.50	V	—
消費電流	I _{DD}	平均値		—	1.4	3.0	μA	1
出力電圧	V _{OUT}	Nchオープン ドレイン出力品	出力トランジスタNch、 I _{OUT} = 0.5 mA	—	—	0.4	V	2
		CMOS出力品	出力トランジスタNch、 I _{OUT} = 0.5 mA	—	—	0.4	V	2
			出力トランジスタPch、 I _{OUT} = -0.5 mA	V _{DD} - 0.4	—	—	V	3
リーク電流	I _{LEAK}	Nchオープンドレイン出力品 出力トランジスタNch、V _{OUT} = 3.5 V		—	—	1	μA	4
アウェイクモード時間	t _{AW}	—		—	0.05	—	ms	—
スリープモード時間	t _{SL}	—		—	50.80	—	ms	—
駆動周期	t _{CYCLE}	t _{AW} + t _{SL}		—	50.85	100.00	ms	—

■ 磁気的特性

1. 両極検知品

1.1 $B_{OP} = 3.0 \text{ mT typ.品}$

表11

(特記なき場合 : $T_a = +25^\circ\text{C}$ 、 $V_{DD} = 1.85 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = 0 \text{ V}$)

項目		記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位	測定回路
動作点 ^{*1}	S極	B_{OPS}	—	1.4	3.0	4.0	mT	5
	N極	B_{OPN}	—	-4.0	-3.0	-1.4	mT	5
復帰点 ^{*2}	S極	B_{RPS}	—	1.1	2.2	3.7	mT	5
	N極	B_{RPN}	—	-3.7	-2.2	-1.1	mT	5
ヒステリシス幅 ^{*3}	S極	B_{HYSS}	$B_{HYSS} = B_{OPS} - B_{RPS}$	—	0.8	—	mT	5
	N極	B_{HYSN}	$B_{HYSN} = B_{OPN} - B_{RPN} $	—	0.8	—	mT	5

1.2 $B_{OP} = 4.5 \text{ mT typ.品}$

表12

(特記なき場合 : $T_a = +25^\circ\text{C}$ 、 $V_{DD} = 1.85 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = 0 \text{ V}$)

項目		記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位	測定回路
動作点 ^{*1}	S極	B_{OPS}	—	2.5	4.5	6.0	mT	5
	N極	B_{OPN}	—	-6.0	-4.5	-2.5	mT	5
復帰点 ^{*2}	S極	B_{RPS}	—	2.0	3.5	5.5	mT	5
	N極	B_{RPN}	—	-5.5	-3.5	-2.0	mT	5
ヒステリシス幅 ^{*3}	S極	B_{HYSS}	$B_{HYSS} = B_{OPS} - B_{RPS}$	—	1.0	—	mT	5
	N極	B_{HYSN}	$B_{HYSN} = B_{OPN} - B_{RPN} $	—	1.0	—	mT	5

2. S極検知品

2.1 $B_{OP} = 3.0 \text{ mT typ.品}$

表13

(特記なき場合 : $T_a = +25^\circ\text{C}$ 、 $V_{DD} = 1.85 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = 0 \text{ V}$)

項目		記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位	測定回路
動作点 ^{*1}	S極	B_{OPS}	—	1.4	3.0	4.0	mT	5
復帰点 ^{*2}	S極	B_{RPS}	—	1.1	2.2	3.7	mT	5
ヒステリシス幅 ^{*3}	S極	B_{HYSS}	$B_{HYSS} = B_{OPS} - B_{RPS}$	—	0.8	—	mT	5

2.2 $B_{OP} = 4.5 \text{ mT typ.品}$

表14

(特記なき場合 : $T_a = +25^\circ\text{C}$ 、 $V_{DD} = 1.85 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = 0 \text{ V}$)

項目		記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位	測定回路
動作点 ^{*1}	S極	B_{OPS}	—	2.5	4.5	6.0	mT	5
復帰点 ^{*2}	S極	B_{RPS}	—	2.0	3.5	5.5	mT	5
ヒステリシス幅 ^{*3}	S極	B_{HYSS}	$B_{HYSS} = B_{OPS} - B_{RPS}$	—	1.0	—	mT	5

3. N極検知品

3.1 B_{OP} = 3.0 mT typ.品

表15

(特記なき場合 : Ta = +25°C、V_{DD} = 1.85 V、V_{SS} = 0 V)

項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位	測定回路	
動作点 ^{*1}	N極	B _{OPN}	—	-4.0	-3.0	-1.4	mT	5
復帰点 ^{*2}	N極	B _{RPN}	—	-3.7	-2.2	-1.1	mT	5
ヒステリシス幅 ^{*3}	N極	B _{HYSN}	B _{HYSN} = B _{OPN} - B _{RPN}	—	0.8	—	mT	5

3.2 B_{OP} = 4.5 mT typ.品

表16

(特記なき場合 : Ta = +25°C、V_{DD} = 1.85 V、V_{SS} = 0 V)

項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位	測定回路	
動作点 ^{*1}	N極	B _{OPN}	—	-6.0	-4.5	-2.5	mT	5
復帰点 ^{*2}	N極	B _{RPN}	—	-5.5	-3.5	-2.0	mT	5
ヒステリシス幅 ^{*3}	N極	B _{HYSN}	B _{HYSN} = B _{OPN} - B _{RPN}	—	1.0	—	mT	5

*1. B_{OPN}, B_{OPS}: 動作点

磁石 (N極またはS極) からS-5712シリーズが受ける磁束密度を大きくした (磁石を近づけた) とき、出力電圧 (V_{OUT}) が反転する時点の磁束密度の値を指します。

B_{OPN}, B_{OPS}より磁束密度を大きくしても、V_{OUT}は状態を保持します。

*2. B_{RPN}, B_{RPS}: 復帰点

磁石 (N極またはS極) からS-5712シリーズが受ける磁束密度を小さくした (磁石を遠ざけた) とき、出力電圧 (V_{OUT}) が反転する時点の磁束密度の値を指します。

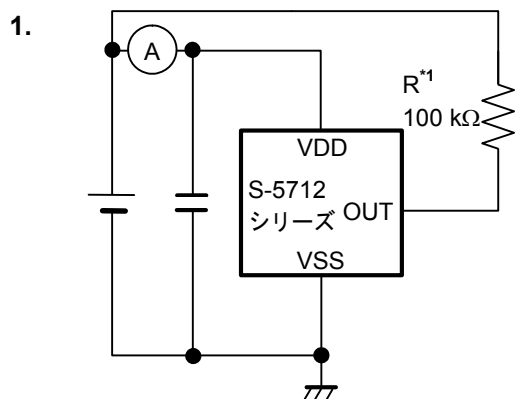
B_{RPN}, B_{RPS}より磁束密度を小さくしても、V_{OUT}は状態を保持します。

*3. B_{HYSN}, B_{HYS}: ヒステリシス幅

B_{OPN}とB_{RPN}、およびB_{OPS}とB_{RPS}の磁束密度の差をそれぞれ表します。

備考 磁束密度の単位mTは、1 mT = 10 Gauss換算となります。

■ 測定回路



*1. CMOS出力品の場合、抵抗 (R) は不要です。

図6

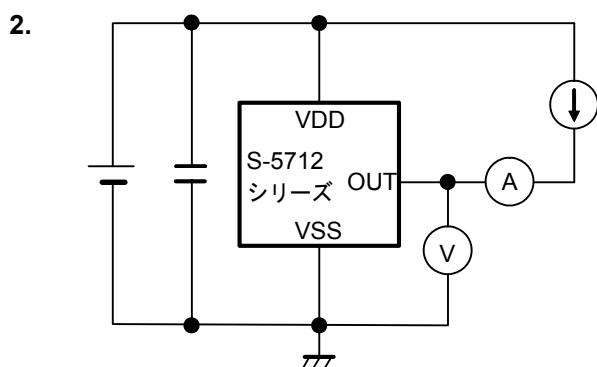


図7

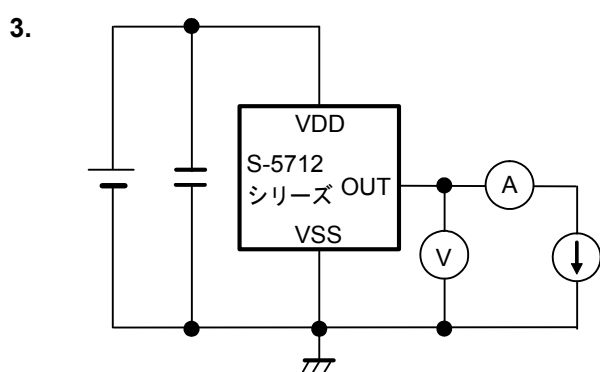


図8

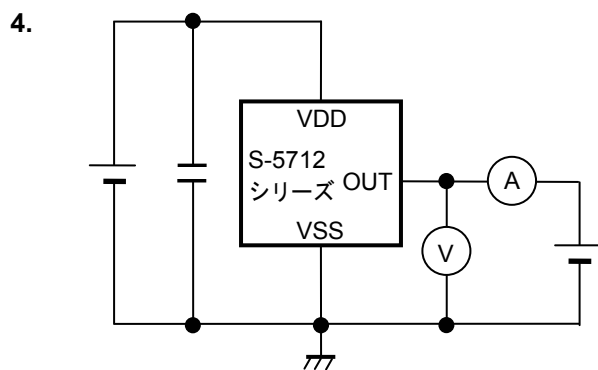
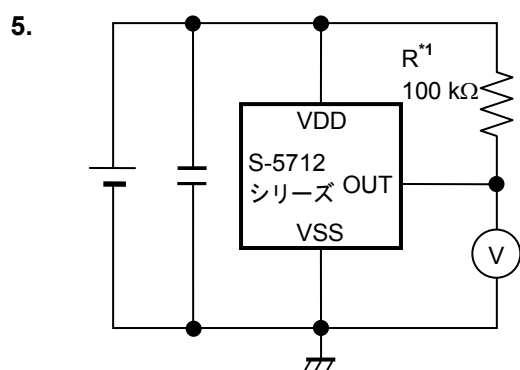


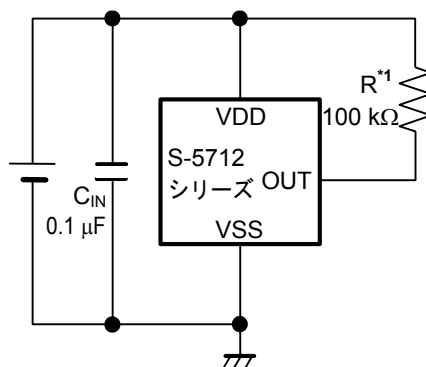
図9



*1. CMOS出力品の場合、抵抗 (R) は不要です。

図10

■ 標準回路



*1. CMOS出力品の場合、抵抗 (R) は不要です。

図11

注意 上記接続図および定数は、動作を保証するものではありません。実際のアプリケーションで十分な評価の上、定数を設定してください。

■ 動作説明

1. 磁束印加方向

S-5712シリーズは、マーキング面に対して垂直方向の磁束密度を検出します。

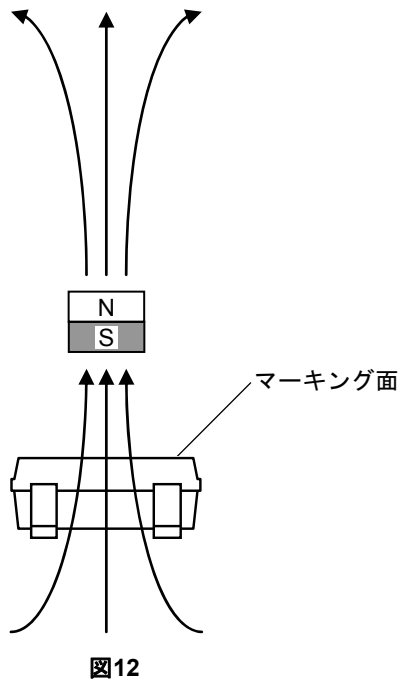
両極検知品の場合は、マーキング面にS極またはN極を近づけると出力電圧 (V_{OUT}) が反転します。

S極検知品の場合は、マーキング面にS極を近づけると出力電圧 (V_{OUT}) が反転します。

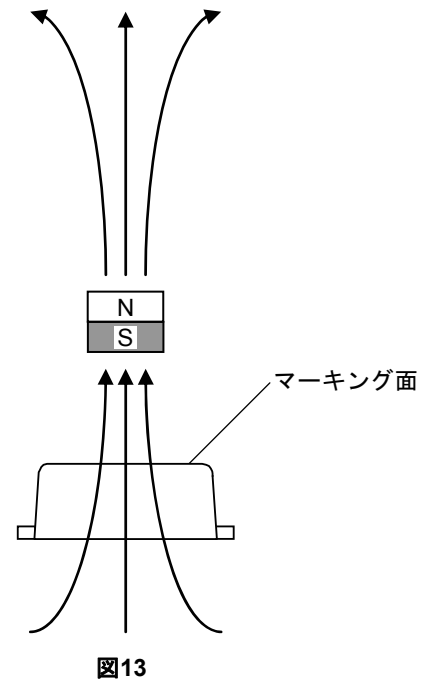
N極検知品の場合は、マーキング面にN極を近づけると出力電圧 (V_{OUT}) が反転します。

図12、13に、磁束印加方向を示します。

1.1 SOT-23-3 の場合



1.2 SNT-4A の場合



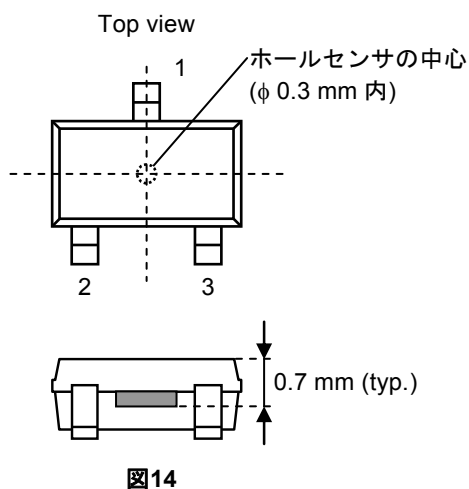
2. ホールセンサ位置

図14、15に、ホールセンサの位置を示します。

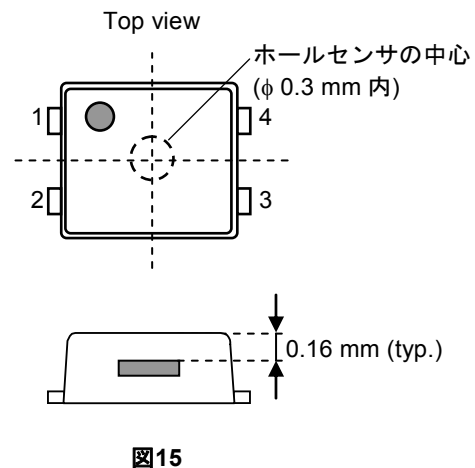
ホールセンサの中心は、下図に示すようにパッケージ中央の丸印で示した領域に位置します。

また、パッケージのマーキング面からチップ表面までの距離 (typ.値) も示します。

2.1 SOT-23-3 の場合



2.2 SNT-4A の場合



3. 基本動作

S-5712シリーズは、磁石などから受ける磁束密度 (N極またはS極) の大小により出力電圧 (V_{OUT}) レベルを切り換えます。

以下に、磁気検出論理がアクティブ "L" の場合の動作を説明します。

3.1 両極検知品の場合

磁石のS極またはN極がS-5712シリーズのマーキング面に近づき、マーキング面に対し垂直方向の磁束密度が B_{OPN} または B_{OPS} より大きくなると、 V_{OUT} は "H" から "L" へ変化します。また、磁石のS極またはN極がS-5712シリーズのマーキング面から遠ざかり、磁束密度が B_{RPN} または B_{RPS} より小さくなると、 V_{OUT} は "L" から "H" へ変化します。

図16に、磁束密度と V_{OUT} の関係を示します。

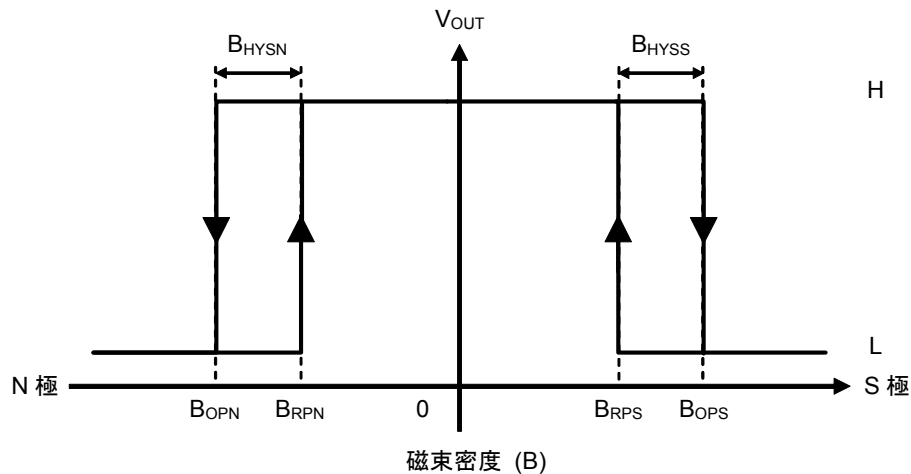


図16

3.2 S極検知品の場合

磁石のS極がS-5712シリーズのマーキング面に近づき、マーキング面に対し垂直方向の磁束密度が B_{OPS} より大きくなると、 V_{OUT} は "H" から "L" へ変化します。また、磁石のS極がS-5712シリーズのマーキング面から遠ざかり、磁束密度が B_{RPS} より小さくなると、 V_{OUT} は "L" から "H" へ変化します。

図17に、磁束密度と V_{OUT} の関係を示します。

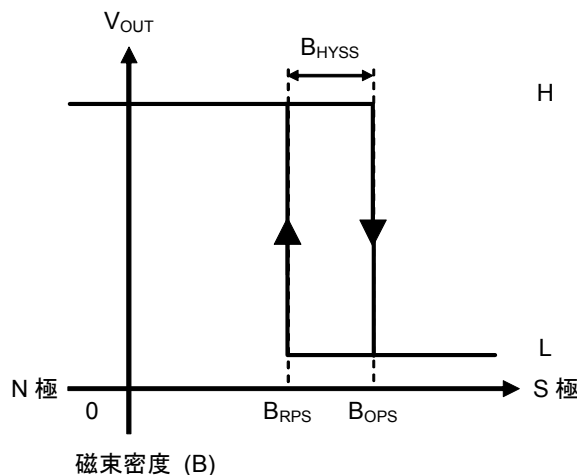


図17

3.3 N極検知品の場合

磁石のN極がS-5712シリーズのマーキング面に近づき、マーキング面に対し垂直方向の磁束密度が B_{OPN} より大きくなると、 V_{OUT} は "H" から "L" へ変化します。また、磁石のN極がS-5712シリーズのマーキング面から遠ざかり、磁束密度が B_{RPN} より小さくなると、 V_{OUT} は "L" から "H" へ変化します。

図18に、磁束密度と V_{OUT} の関係を示します。

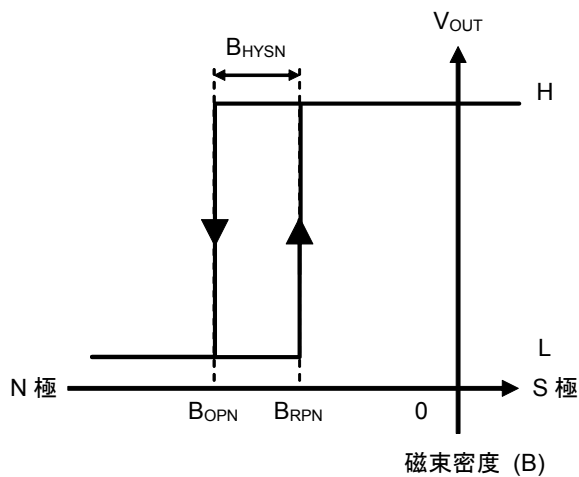


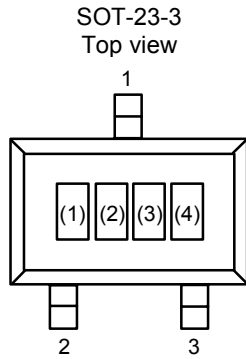
図18

■ 注意事項

- ・電源のインピーダンスが高い場合、貫通電流などを原因とした電源電圧降下によって、ICが誤動作する可能性があります。電源のインピーダンスが低くなるように十分注意してパターン配線してください。
- ・電源電圧が急峻に変化すると、ICが誤動作する可能性がありますので注意してください。
- ・本ICは静電気に対する保護回路が内蔵されていますが、保護回路の性能を超える過大静電気がICに印加されないようにしてください。
- ・本ICに大きな応力が加わると、磁気的特性が変化することがあります。基板に実装する際の基板の曲がりや歪み、実装後の取り扱いなどによりICに大きな応力が加わらないように注意してください。
- ・弊社ICを使用して製品を作る場合には、その製品での当ICの使い方や製品の仕様、出荷先の国などによって当ICを含めた製品が特許に抵触した場合、その責任は負いかねます。

■ マーキング仕様

1. SOT-23-3



(1) ~ (3)
(4)

: 製品略号 (製品名と製品略号の対照表を参照)
: ロットナンバー

製品名と製品略号の対照表

1. 1 Nchオープンドレイン出力品

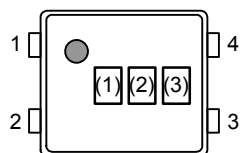
製品名	製品略号		
	(1)	(2)	(3)
S-5712ANDL1-M3T1U	X	A	B
S-5712ANDL2-M3T1U	X	A	C
S-5712ANSL1-M3T1U	X	A	J
S-5712ANSL2-M3T1U	X	A	K

1. 2 CMOS出力品

製品名	製品略号		
	(1)	(2)	(3)
S-5712ACDL1-M3T1U	X	B	B
S-5712ACDL2-M3T1U	X	B	C
S-5712ACDH1-M3T1U	X	B	F
S-5712ACDH2-M3T1U	X	B	G
S-5712ACSL1-M3T1U	X	B	J
S-5712ACSL2-M3T1U	X	B	K
S-5712ACNL1-M3T1U	X	B	R
S-5712ACNL2-M3T1U	X	B	S

2. SNT-4A

SNT-4A
Top view



(1) ~ (3)

: 製品略号 (製品名と製品略号の対照表を参照)

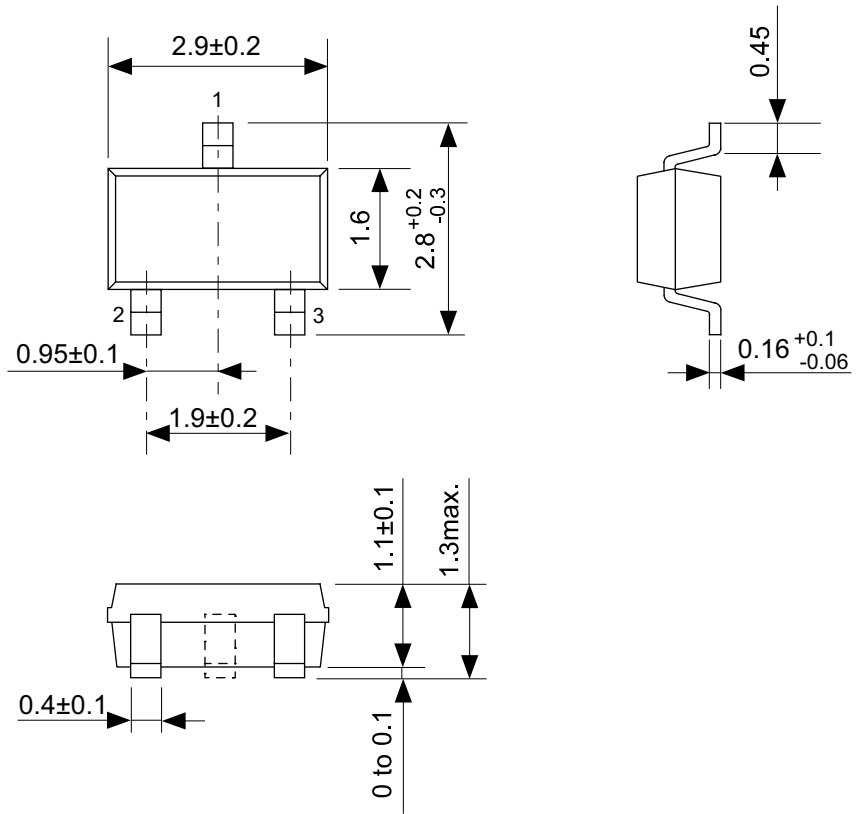
製品名と製品略号の対照表

2.1 Nchオープンドレイン出力品

製品名	製品略号		
	(1)	(2)	(3)
S-5712ANDL1-I4T1U	X	A	B
S-5712ANDL2-I4T1U	X	A	C
S-5712ANSL1-I4T1U	X	A	J
S-5712ANSL2-I4T1U	X	A	K

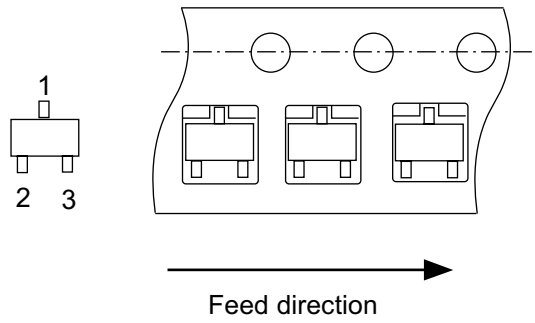
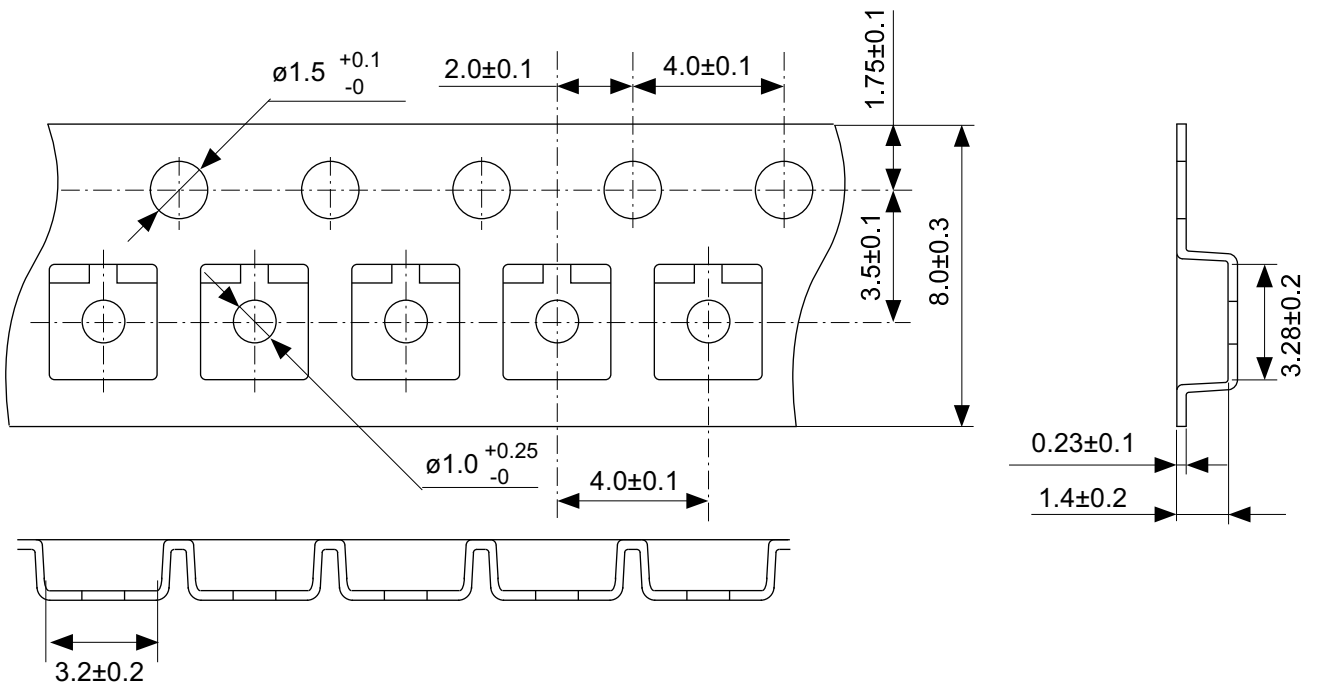
2.2 CMOS出力品

製品名	製品略号		
	(1)	(2)	(3)
S-5712ACDL1-I4T1U	X	B	B
S-5712ACDL2-I4T1U	X	B	C
S-5712ACDH1-I4T1U	X	B	F
S-5712ACDH2-I4T1U	X	B	G
S-5712ACSL1-I4T1U	X	B	J
S-5712ACSL2-I4T1U	X	B	K
S-5712ACNL1-I4T1U	X	B	R
S-5712ACNL2-I4T1U	X	B	S



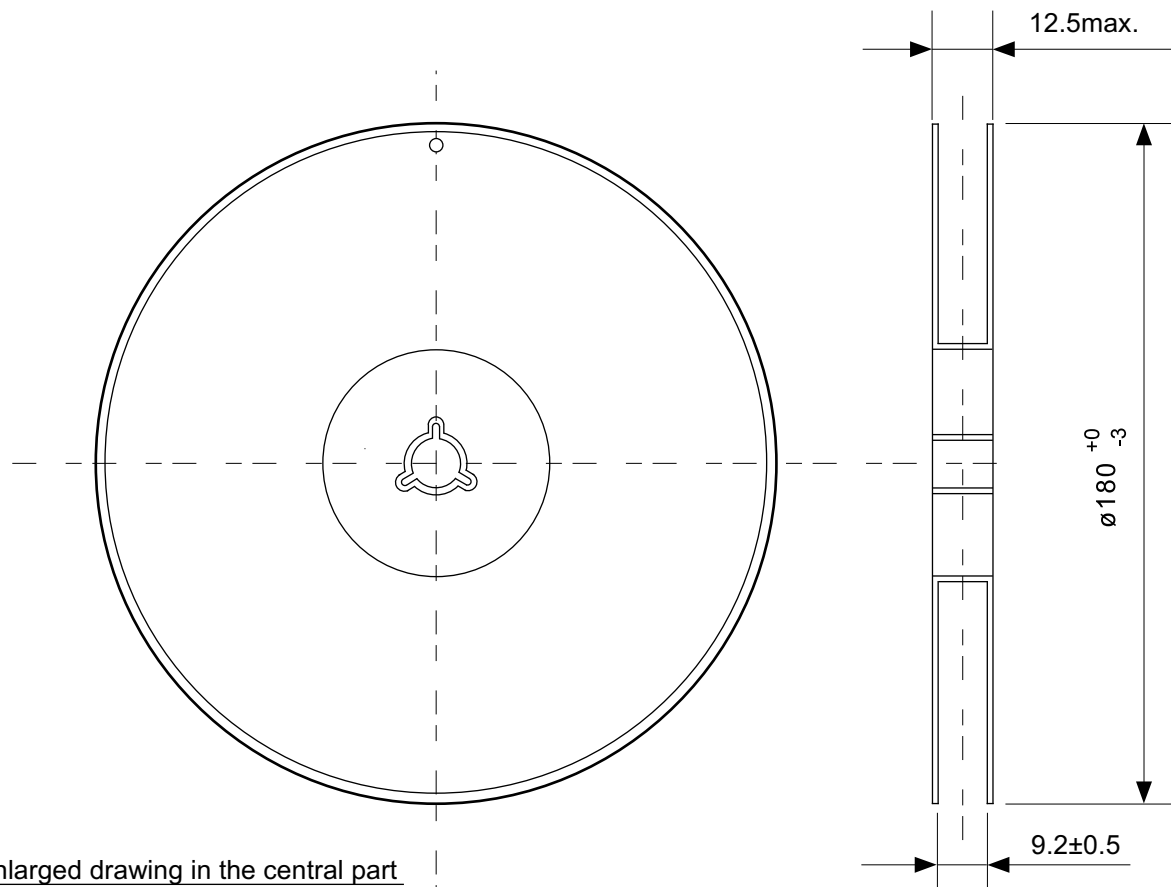
No. MP003-C-P-SD-1.0

TITLE	SOT233-C-PKG Dimensions
No.	MP003-C-P-SD-1.0
SCALE	
UNIT	mm
Seiko Instruments Inc.	

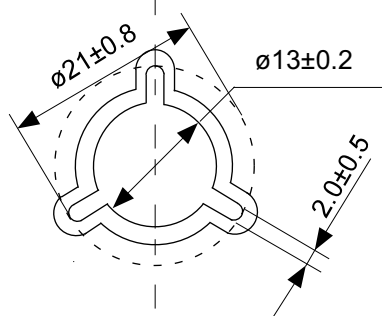


No. MP003-C-C-SD-2.0

TITLE	SOT233-C-Carrier Tape
No.	MP003-C-C-SD-2.0
SCALE	
UNIT	mm
Seiko Instruments Inc.	

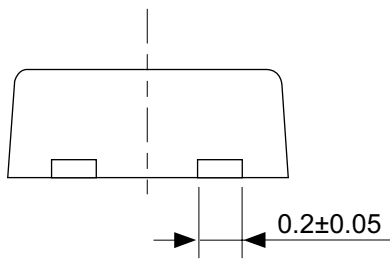
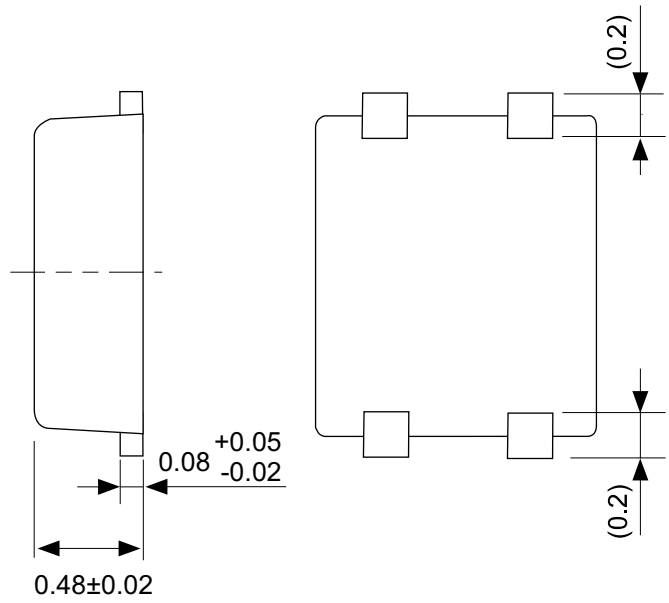
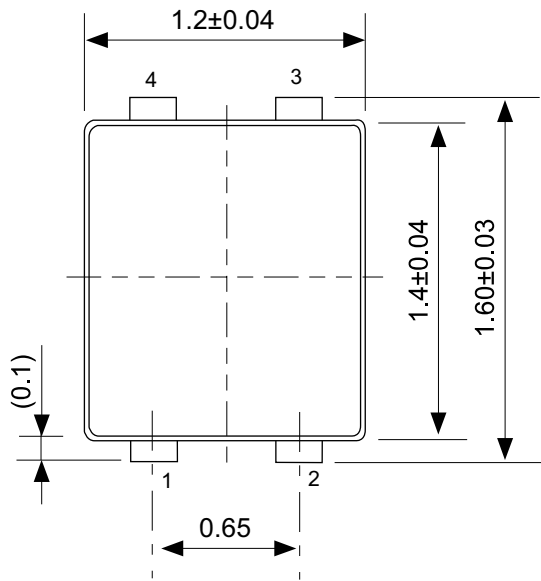


Enlarged drawing in the central part



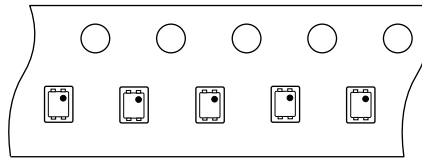
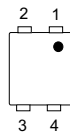
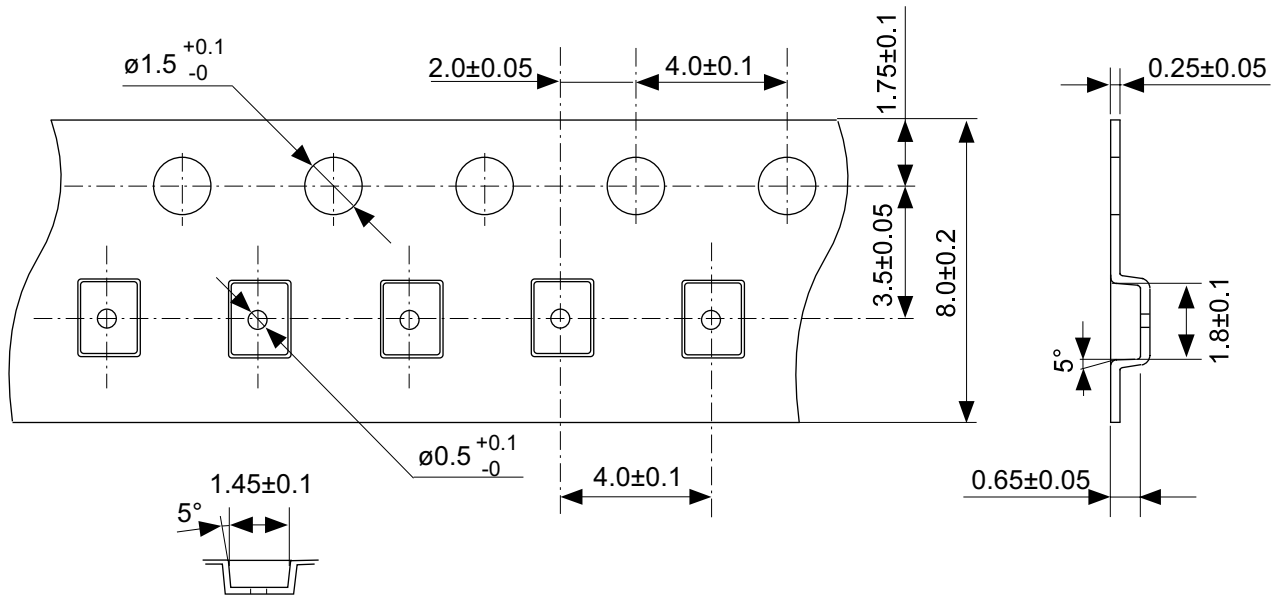
No. MP003-Z-R-SD-1.0

TITLE	SOT233-C-Reel		
No.	MP003-Z-R-SD-1.0		
SCALE		QTY.	3,000
UNIT	mm		
Seiko Instruments Inc.			



No. PF004-A-P-SD-4.0

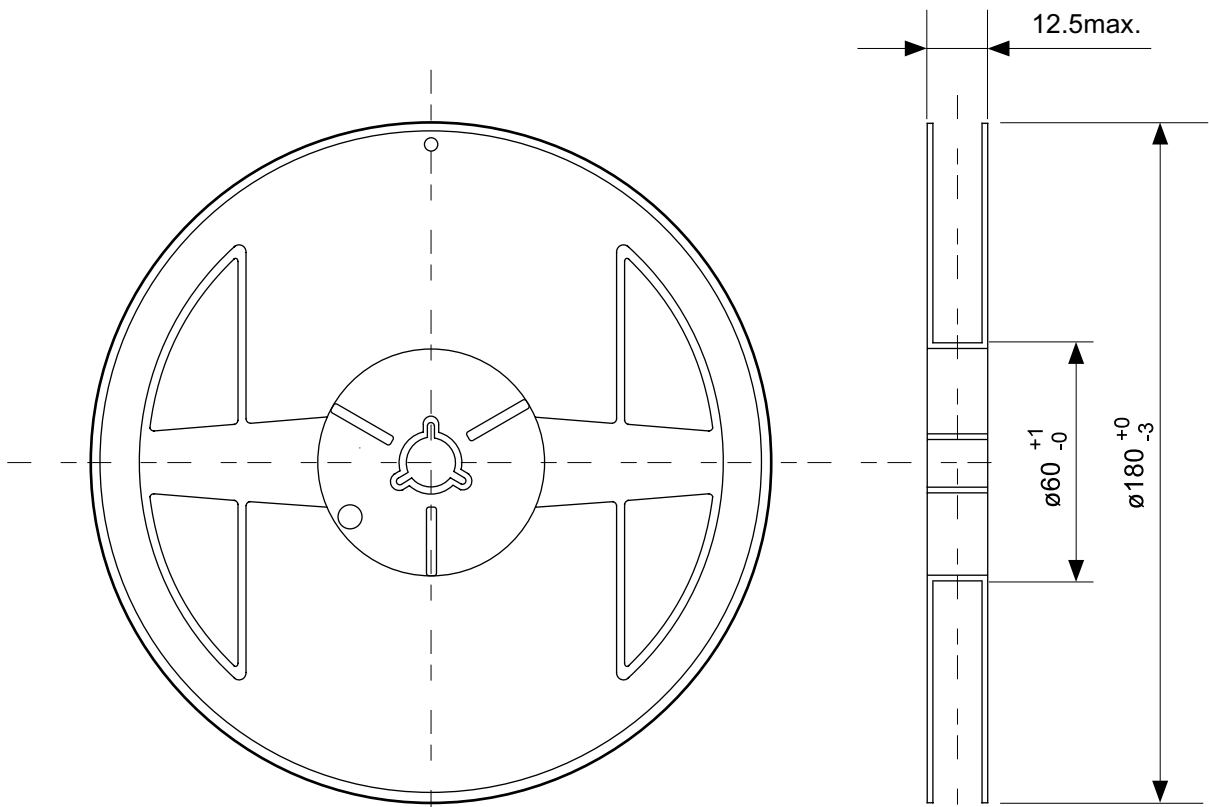
TITLE	SNT-4A-A-PKG Dimensions
No.	PF004-A-P-SD-4.0
SCALE	
UNIT	mm
Seiko Instruments Inc.	



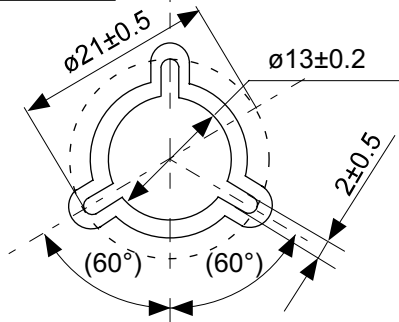
Feed direction →

No. PF004-A-C-SD-1.0

TITLE	SNT-4A-A-Carrier Tape
No.	PF004-A-C-SD-1.0
SCALE	
UNIT	mm
Seiko Instruments Inc.	

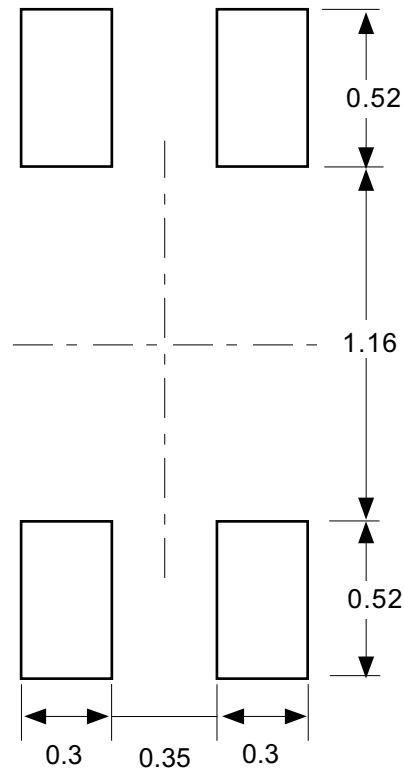


Enlarged drawing in the central part



No. PF004-A-R-SD-1.0

TITLE	SNT-4A-A-Reel		
No.	PF004-A-R-SD-1.0		
SCALE		QTY.	5,000
UNIT	mm		
Seiko Instruments Inc.			



Caution Making the wire pattern under the package is possible. However, note that the package may be upraised due to the thickness made by the silk screen printing and of a solder resist on the pattern because this package does not have the standoff.

注意 パッケージ下への配線パターン形成は可能ですが、本パッケージはスタンドオフが無いので、パターン上のレジスト厚み、シルク印刷の厚みによってパッケージが持ち上がる場合がありますのでご配慮ください。

No. PF004-A-L-SD-3.0

TITLE	SNT-4A-A-Land Recommendation
No.	PF004-A-L-SD-3.0
SCALE	
UNIT	mm
Seiko Instruments Inc.	

SII



セイコーインスツル株式会社
www.sii-ic.com

- 本資料の内容は、製品の改良に伴い、予告なく変更することがあります。
- 本資料に記載されている図面等の第三者の工業所有権に起因する諸問題については弊社はその責任を負いかねます。また、応用回路例は製品の代表的な応用を説明するものであり、量産設計を保証するものではありません。
- 本資料に掲載されている製品が、外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物（又は役務）に該当する場合は、同法に基づく日本国政府の輸出許可が必要です。
- 本資料の内容を弊社に断ることなしに、記載または、複製など他の目的で使用することは堅くお断りします。
- 本資料に記載されている製品は、弊社の書面による許可なくしては、健康機器、医療機器、防災機器、ガス関連機器、車両機器、航空機器、及び車載機器等、人体に影響を及ぼす機器または装置の部品として使用することはできません。
- 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障や誤動作する場合があります。故障や誤動作により、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご注意ください。